

# КРЕМНИЕВЫЙ ТРАНЗИСТОР

*n-p-n*

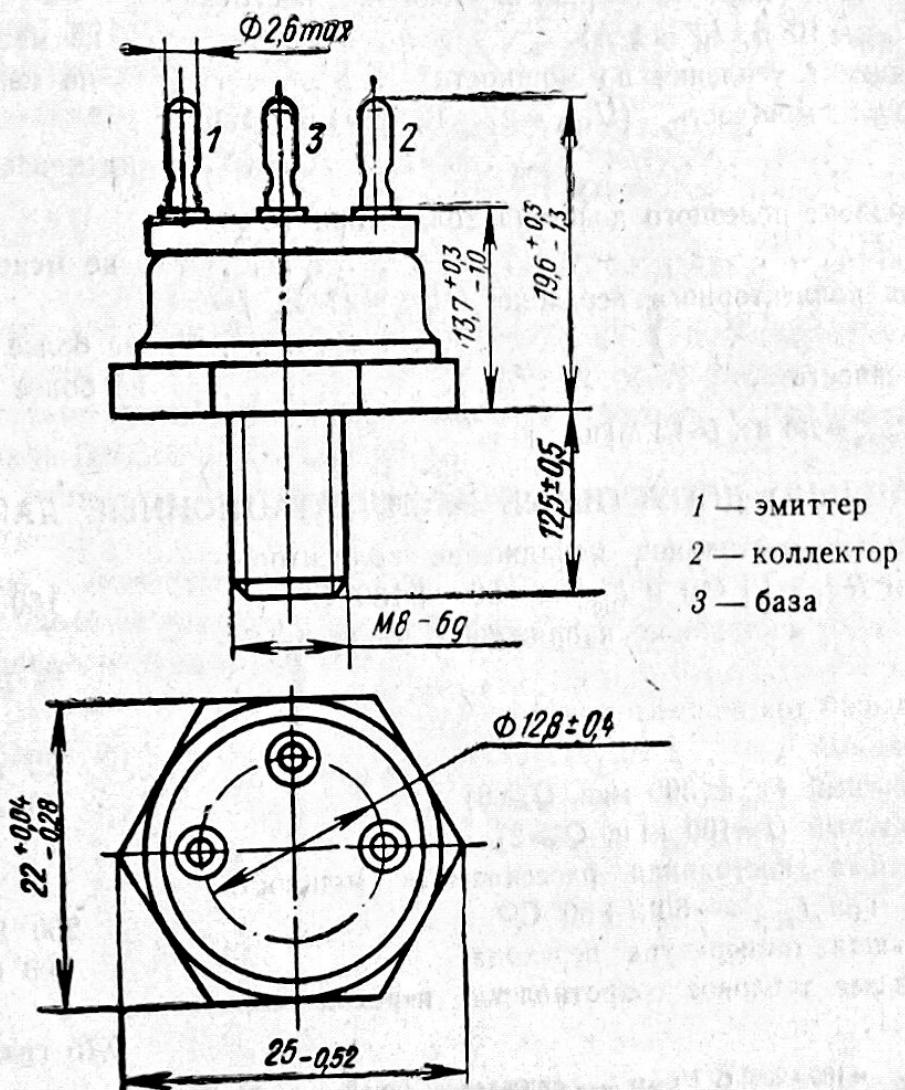
2T947A

По техническим условиям аA0.339.118 ТУ

Основное назначение — работа в аппаратуре специального назначения.  
Оформление — в металлокерамическом корпусе.

## ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Высота наибольшая . . . . .	32,9 мм
Диаметр наибольший . . . . .	22,04 мм
Вес наибольший . . . . .	35 г



Примечание. С 04.05.81. транзисторы 2T947A поставляются в корпусе КТ-5 по ГОСТ 18472-78.

## ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Обратный ток коллектор—эмиттер ( $R_{БЭ} = 10 \text{ Ом}$ ):	
при $t_{\text{кор}} = 25 \pm 10$ и $-60 \pm 3^\circ \text{C}$ ( $U_{КЭ} = 100 \text{ В}$ ) . . . . .	не более 100 мА
при $t_{\text{кор}} = 125 \pm 5^\circ \text{C}$ ( $U_{КЭ} = 90 \text{ В}$ ) . . . . .	не более 160 мА
Обратный ток эмиттера ( $U_{ЭБ} = 5 \text{ В}$ ) . . . . .	не более 150 В
Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером ( $U_{КЭ} = 5 \text{ В}$ , $I_K = 20 \text{ А}$ ):	
при $t_{\text{кор}} = 25 \pm 10^\circ \text{C}$ . . . . .	10—80
при $t_{\text{кор}} = 125 \pm 5^\circ \text{C}$ . . . . .	не более 160
при $t_{\text{кор}} = -60 \pm 3^\circ \text{C}$ . . . . .	5—80
Модуль коэффициента передачи тока на частоте 30 МГц ( $U_{КЭ} = 10 \text{ В}$ , $I_K = 4 \text{ А}$ ) . . . . .	не менее 2,5
Коэффициент усиления по мощности* . . . . .	не менее 10
Выходная мощность ( $U_{КЭ} = 27 \text{ В}$ , $f = 1,5 \text{ МГц}$ , $\eta_K \geq 60\%$ ) . . . . .	не менее 250 Вт
Коэффициент полезного действия коллектора ( $U_K = 27 \text{ В}$ )* . . . . .	не менее 55%
Емкость коллекторного перехода ( $U_{КБ} = 27 \text{ В}$ , $f = 1 \text{ МГц}$ ) . . . . .	не более 850 пФ
Долговечность . . . . .	не более 25 000 ч

\* При  $P_{\text{вых}} = 250 \text{ Вт}$ ,  $f = 1,5 \text{ МГц}$ .

## ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

Наибольшее постоянное напряжение коллектор—эмиттер при $R_{ЭБ} = 10 \text{ Ом}$ и $t_{\text{пер}} = -60 \div +100^\circ \text{C}$ * . . . . .	100 В
Наибольшее постоянное напряжение эмиттер—база <sup>△</sup> . . . . .	5 В
Наибольший ток коллектора $\Delta$ :	
постоянный . . . . .	20 А
импульсный ( $\tau_i \leq 300 \text{ мкс}$ , $Q \geq 6$ ) . . . . .	40 А
импульсный ( $f = 100 \text{ кГц}$ , $Q \geq 2$ ) . . . . .	50 А
Наибольшая постоянная рассеиваемая мощность коллектора при $t_{\text{кор}} = -60 \div +50^\circ \text{C}$ . . . . .	200 Вт
Наибольшая температура перехода . . . . .	200° С
Наибольшее тепловое сопротивление переход—корпус . . . . .	0,75 град/Вт

\* При  $t_{\text{пер}} = 100 \div 200^\circ \text{C}$   $U_{КЭ}$  уменьшается линейно до 70 В.

△ При  $t_{\text{пер}} = -60 \div +200^\circ \text{C}$ .

○ При  $t_{\text{кор}} = -50 \div 125^\circ \text{C}$   $P_K$  макс определяется по формуле

$$P_{K \text{ макс}} = \frac{t_{\text{пер}} - t_{\text{кор}}}{0,75} \cdot 20 \text{ Вт}$$

**КРЕМНИЕВЫЙ ТРАНЗИСТОР**  
*n-p-n*

**2Т947А**

**УСТОЙЧИВОСТЬ ПРОТИВ ВНЕШНИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ**

Temperatura окружающей среды:	
наибольшая (корпуса) . . . . .	+125° С
наименьшая . . . . .	-60° С
Наибольшая относительная влажность при $t_{окр} = 40^{\circ}\text{C}$ . . . . .	98%
Давление окружающей среды:	
наибольшее . . . . .	3 ат
наименьшее . . . . .	$10^{-6}$ мм рт. ст.
Наибольшее ускорение:	
при вибрации* . . . . .	40 g
линейное . . . . .	500 g
при многократных ударах . . . . .	150 g
при одиночных ударах . . . . .	1000 g

\* В диапазоне частот 1—5000 Гц.

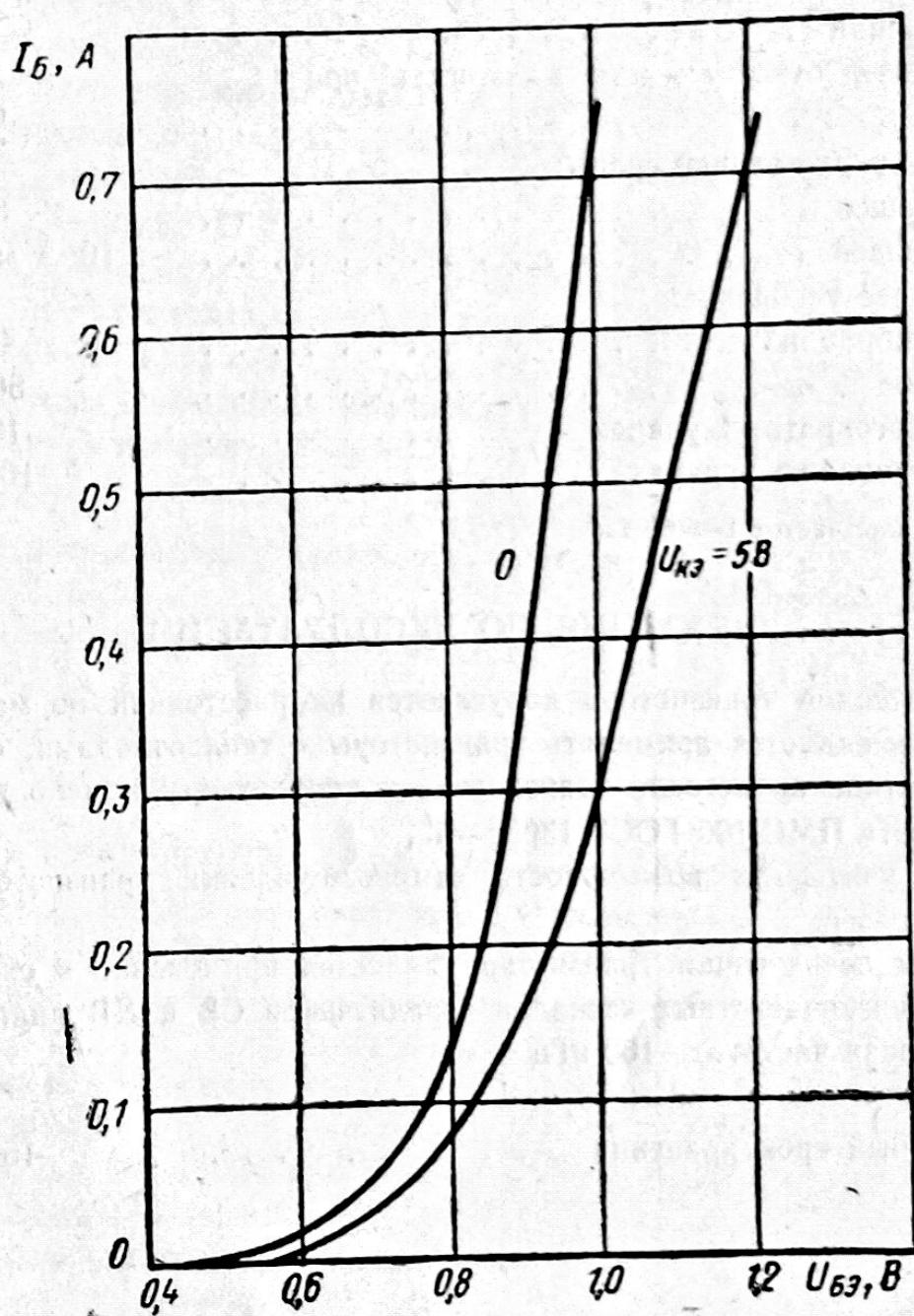
**УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Пайка выводов транзистора допускается на расстояний не менее 2 мм от корпуса. Рекомендуется применять транзисторы с теплоотводами, обращая внимание на плотное прилегание транзистора к теплоотводу и используя смачивающую жидкость ПМС-100 ГОСТ 13032—67.

Следует учитывать возможность самовозбуждения транзисторов за счет паразитных связей.

Основным назначением транзистора является применение в схемах высокочастотных и низкочастотных каскадов передатчиков СВ и ДВ диапазонов. Наименьшая рабочая частота — 100 кГц.

Гарантийный срок хранения . . . . . 15 лет

ВХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
(в схеме с общим эмиттером)

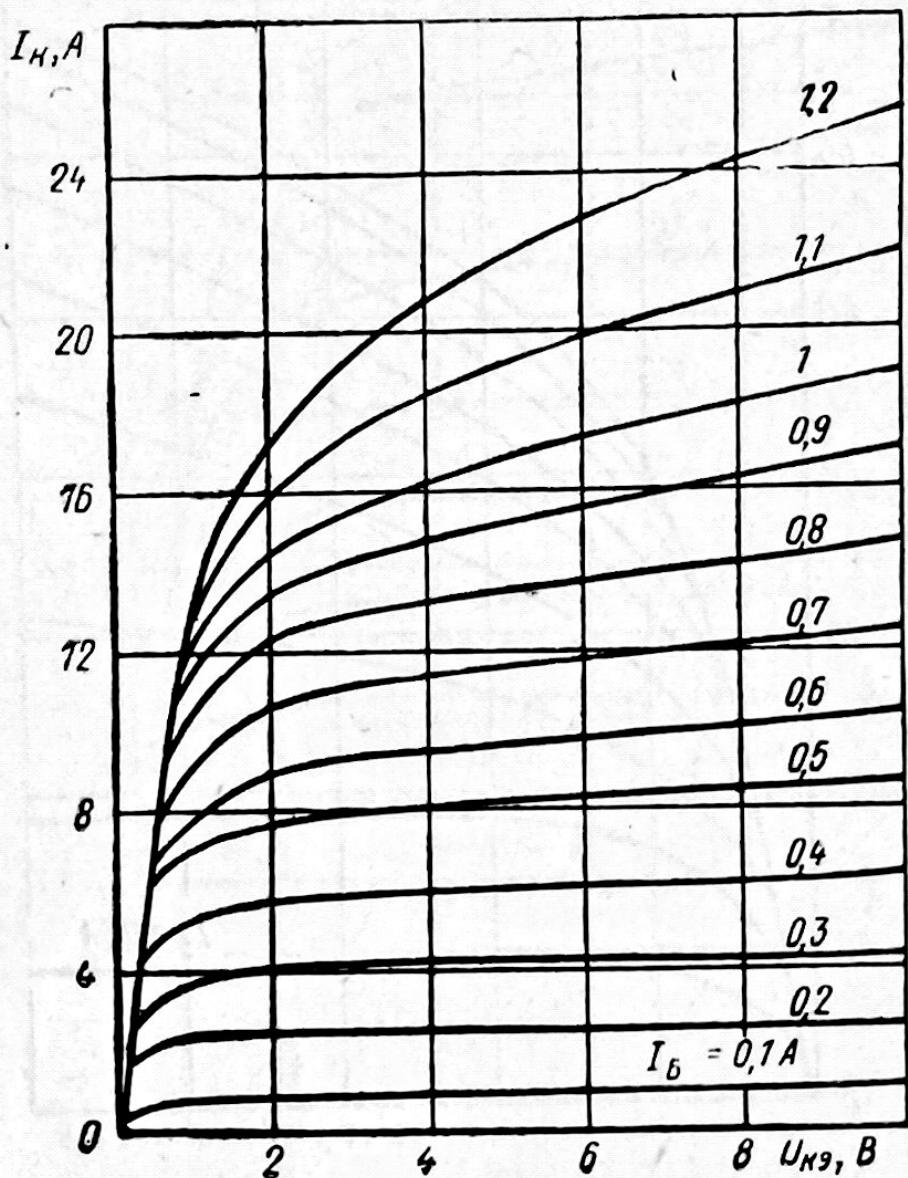
КРЕМНИЕВЫЙ ТРАНЗИСТОР

*n-p-n*

2T947A

ВЫХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

(в схеме с общим эмиттером)

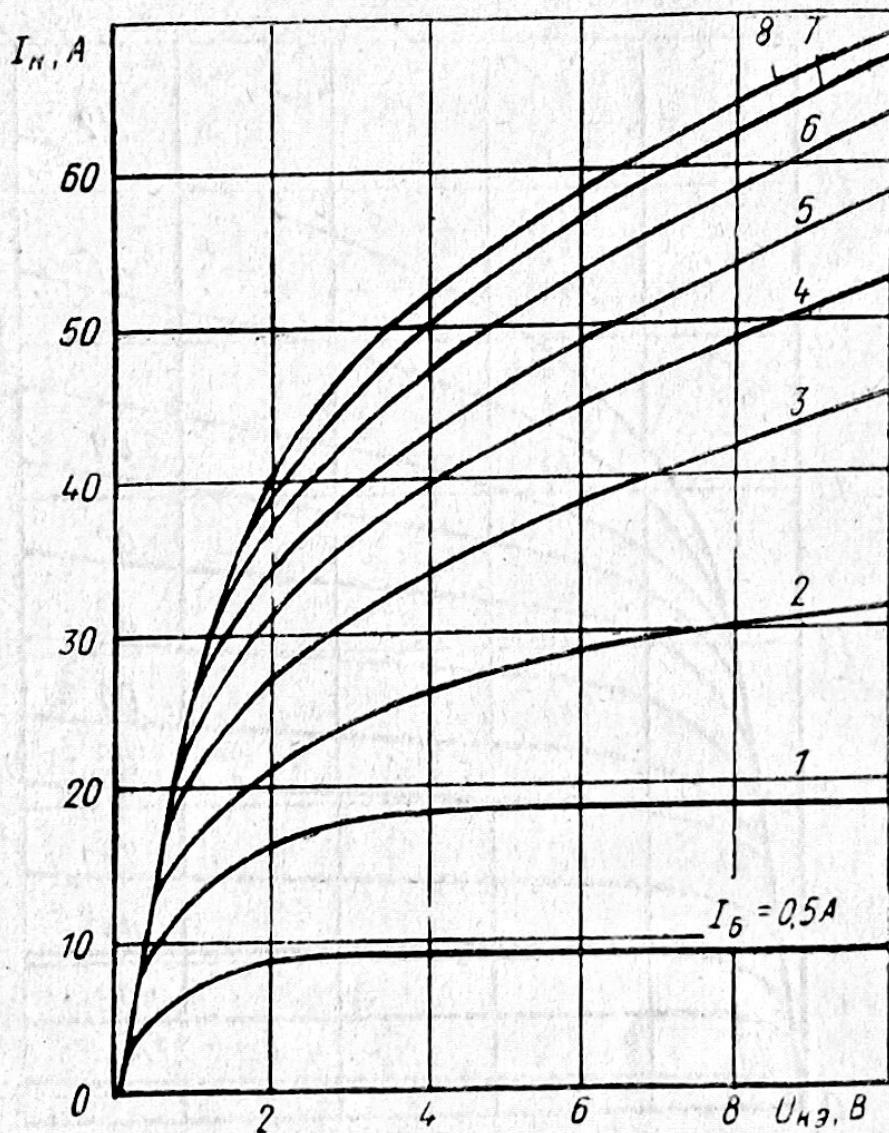


**2Т947А**

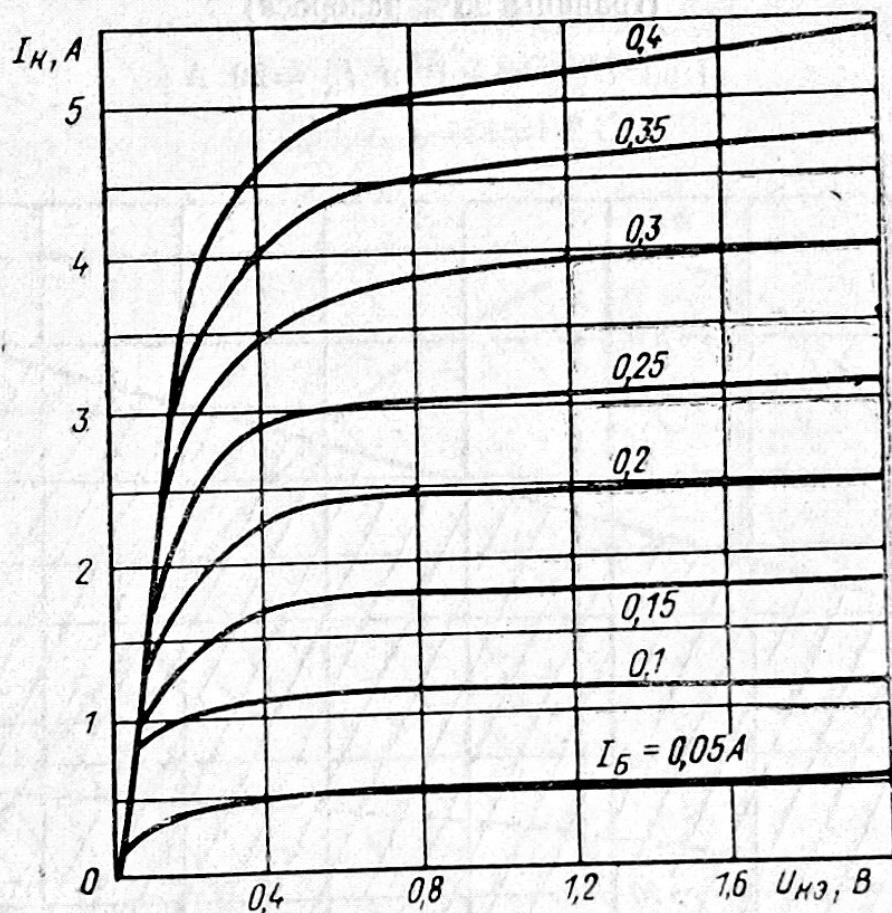
**КРЕМНИЕВЫЙ ТРАНЗИСТОР**

*n-p-n*

**ВЫХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ БОЛЬШИХ ТОКАХ БАЗЫ  
(в схеме с общим эмиттером)**

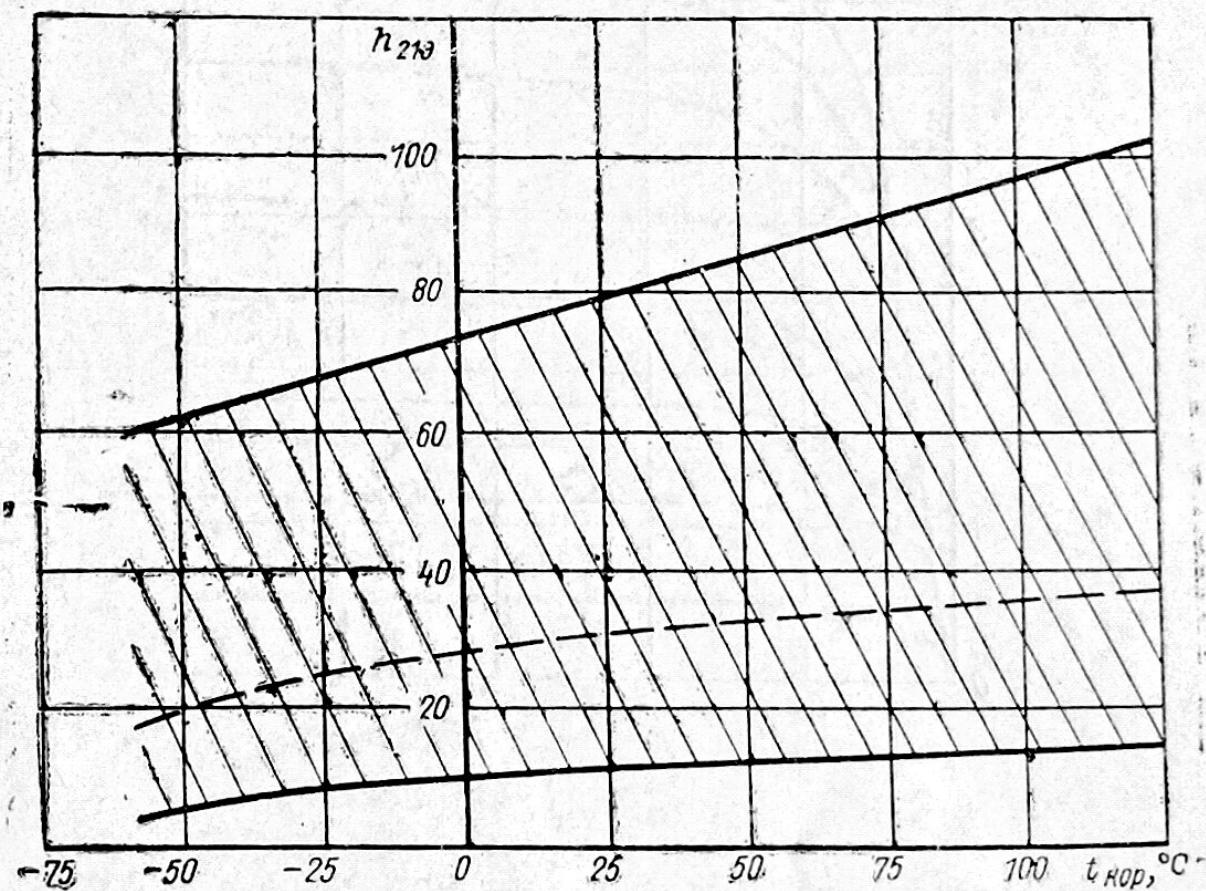


НАЧАЛЬНЫЙ УЧАСТОК ВЫХОДНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК  
(в схеме с общим эмиттером)



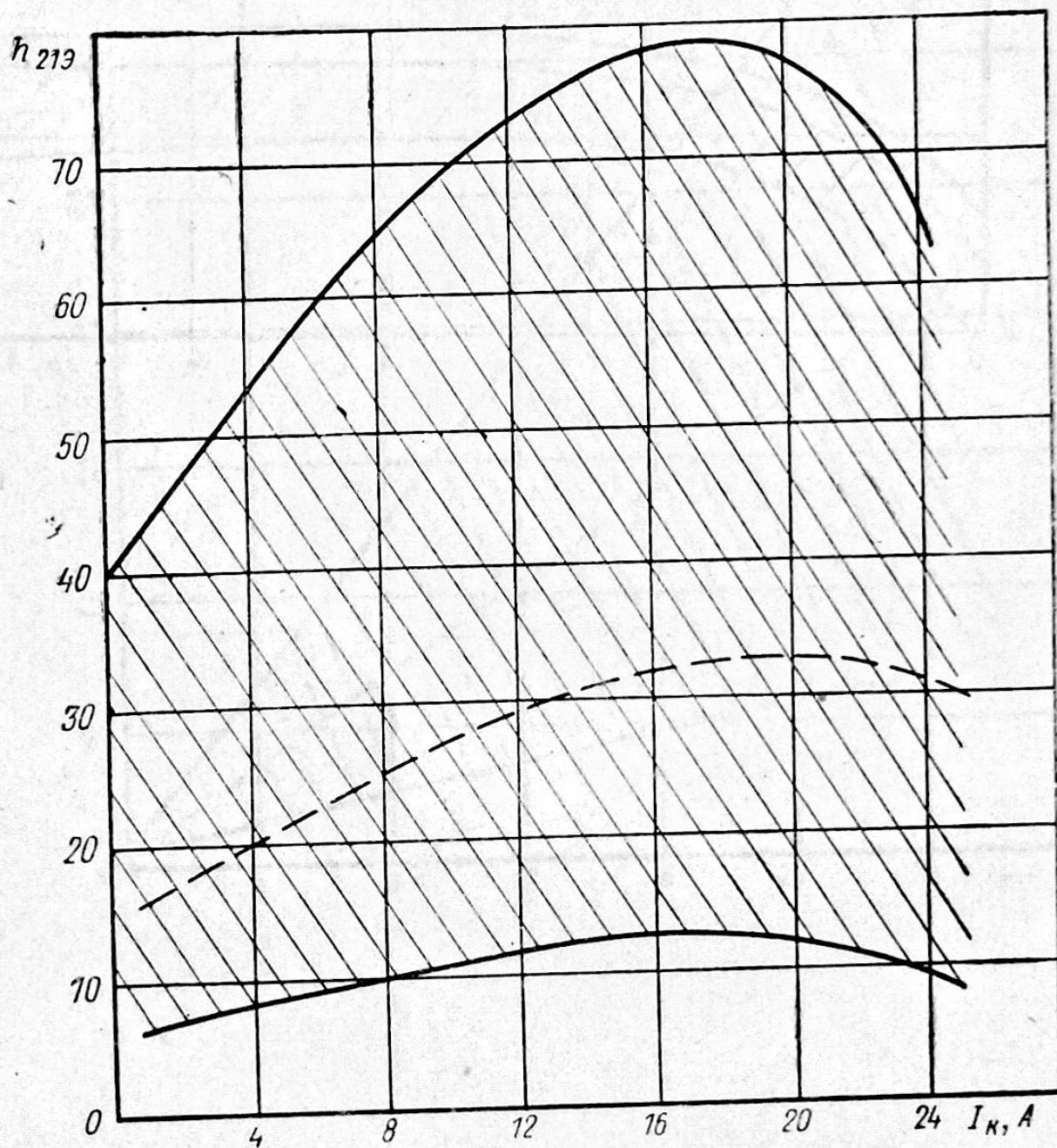
ОБЛАСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ  
СТАТИЧЕСКОГО КОЭФФИЦИЕНТА ПЕРЕДАЧИ ТОКА  
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ КОРПУСА  
(границы 95% разброса)

При  $U_{K\bar{E}} = 5$  В и  $I_K = 20$  А



ОБЛАСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ  
СТАТИЧЕСКОГО КОЭФФИЦИЕНТА ПЕРЕДАЧИ ТОКА  
В СХЕМЕ С ОБЩИМ ЭМИТЕРОМ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТОКА  
КОЛЛЕКТОРА  
(границы 95 % разброса)

При  $t_{\text{кор}} = 25 \pm 10^{\circ}\text{C}$

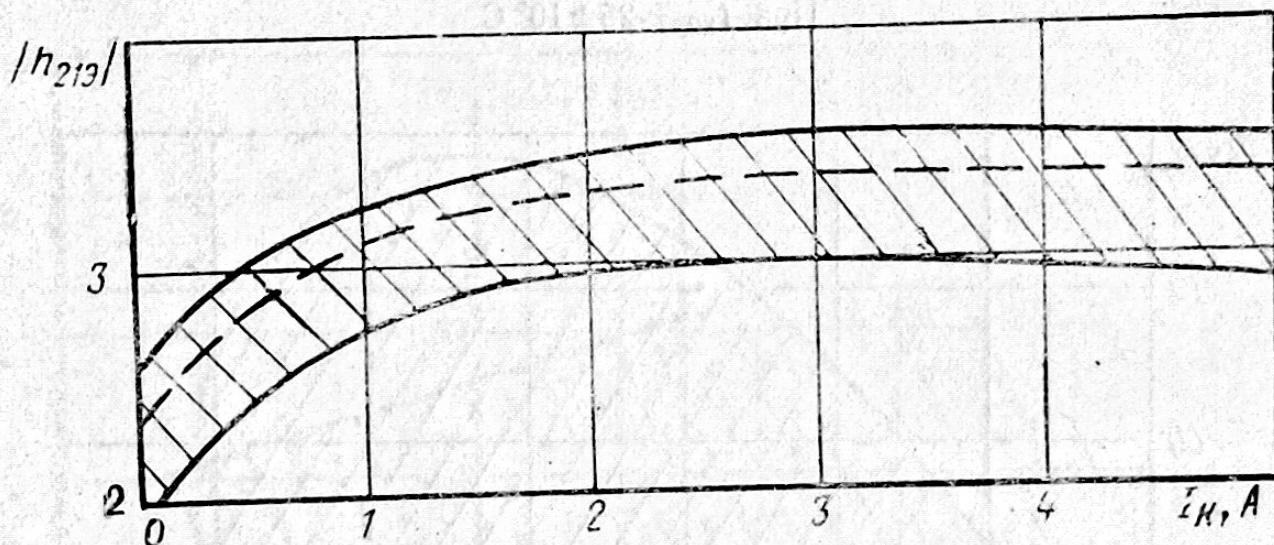


**2T947A**

**КРЕМНИЕВЫЙ ТРАНЗИСТОР**  
*n-p-n*

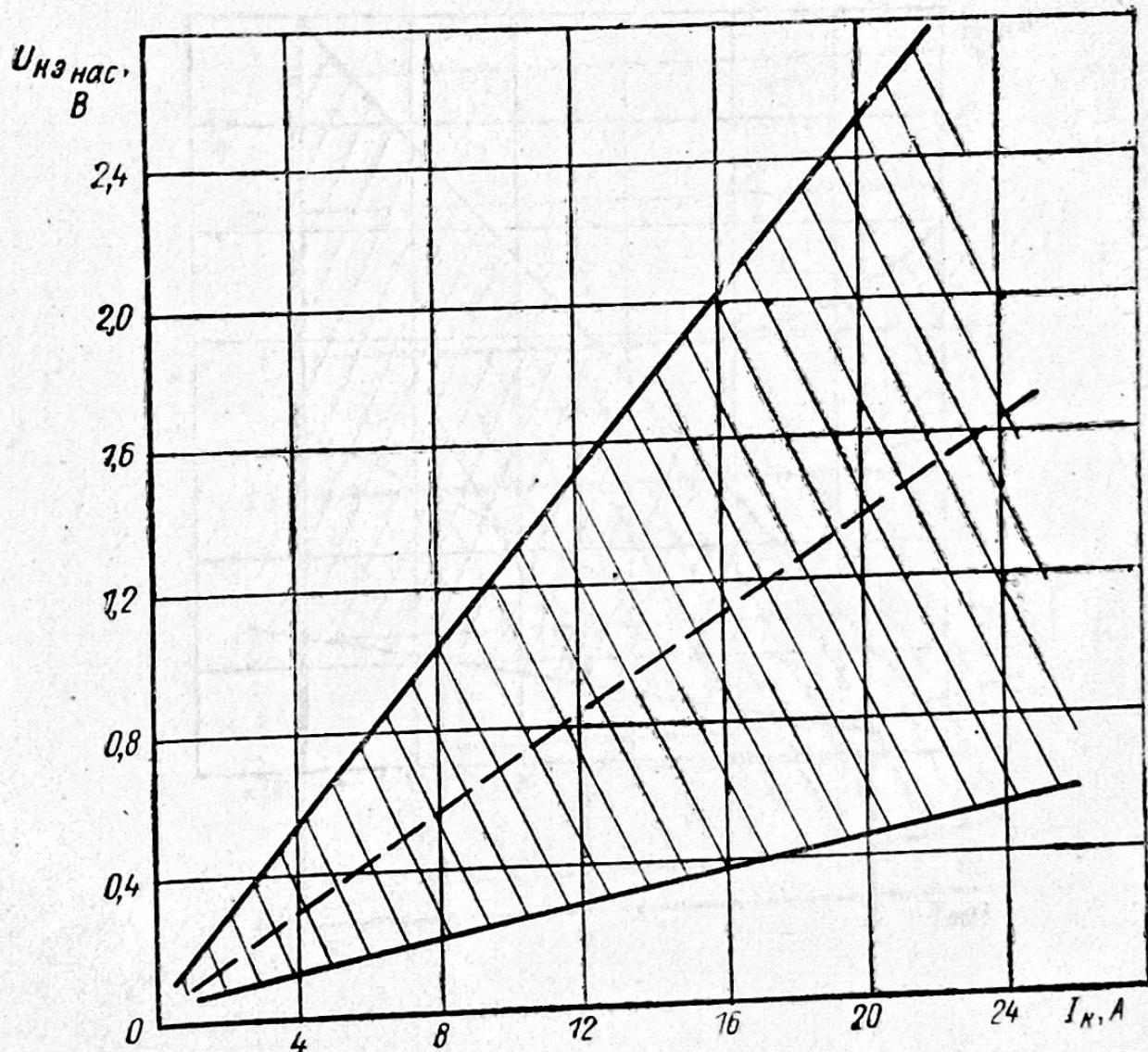
ОБЛАСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ МОДУЛЯ КОЭФФИЦИЕНТА ПЕРЕДАЧИ ТОКА  
НА ЧАСТОТЕ 30 МГц В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТОКА КОЛЛЕКТОРА  
(границы 95% разброса)

При  $U_{K\bar{E}} = 10$  В и  $t_{KOP} = 25 \pm 10^\circ C$



ОБЛАСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ НАСЫЩЕНИЯ  
КОЛЛЕКТОР—ЭМИТЕР В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТОКА КОЛЛЕКТОРА  
(границы 95% разброса)

При  $K_{\text{нас}} = 10$  и  $t_{\text{коп}} = 25 \pm 10^\circ \text{C}$

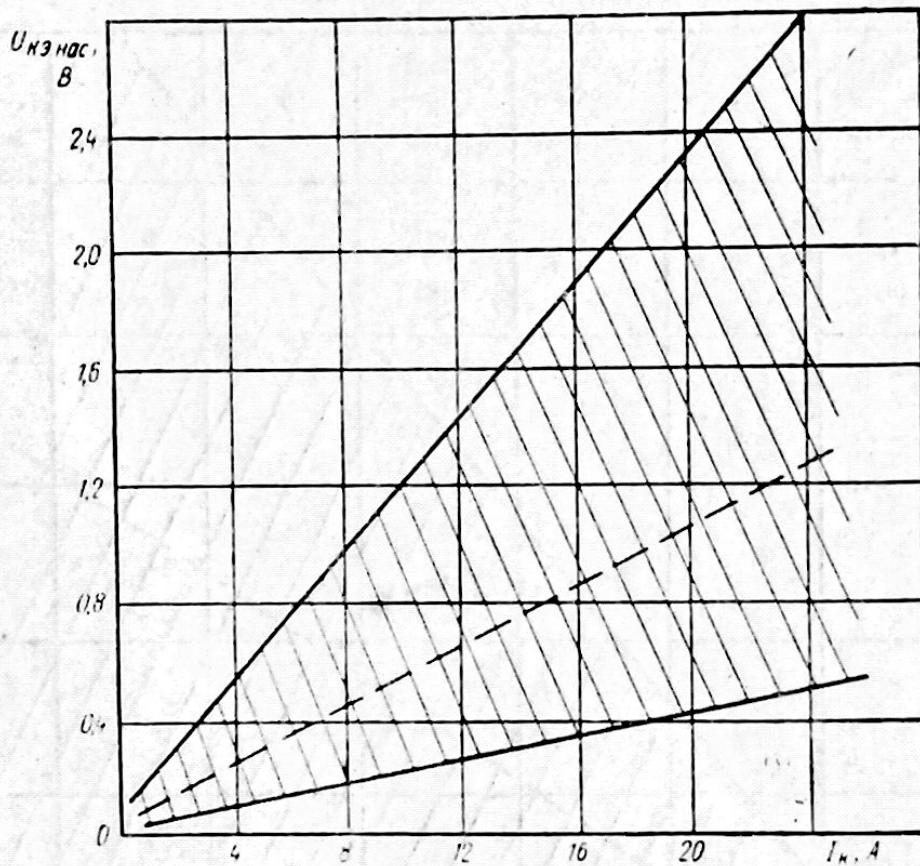


**2T947A**

**КРЕМНИЕВЫЙ ТРАНЗИСТОР**  
*n-p-n*

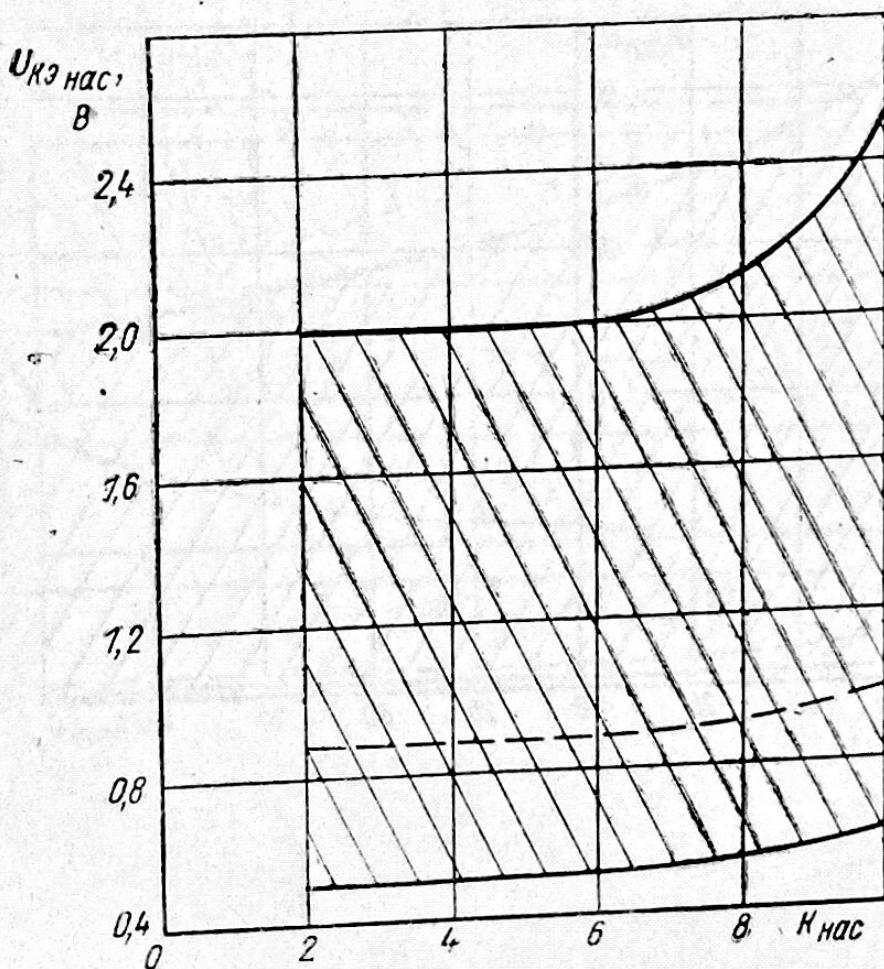
**ОБЛАСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ НАСЫЩЕНИЯ  
КОЛЛЕКТОР-ЭМИТЕР В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТОКА КОЛЛЕКТОРА**  
(границы 95% разброса)

При  $K_{\text{нас}} = 5$  и  $t_{\text{кор}} = 25 \pm 10^\circ \text{C}$



ОБЛАСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ НАСЫЩЕНИЯ  
 КОЛЛЕКТОР—ЭМИТЕР В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОЭФФИЦИЕНТА  
 НАСЫЩЕНИЯ  
 (границы 95% разброса)

При  $I_K = 20 \text{ A}$  и  $t_{\text{кор}} = 25 \pm 10^\circ \text{ C}$

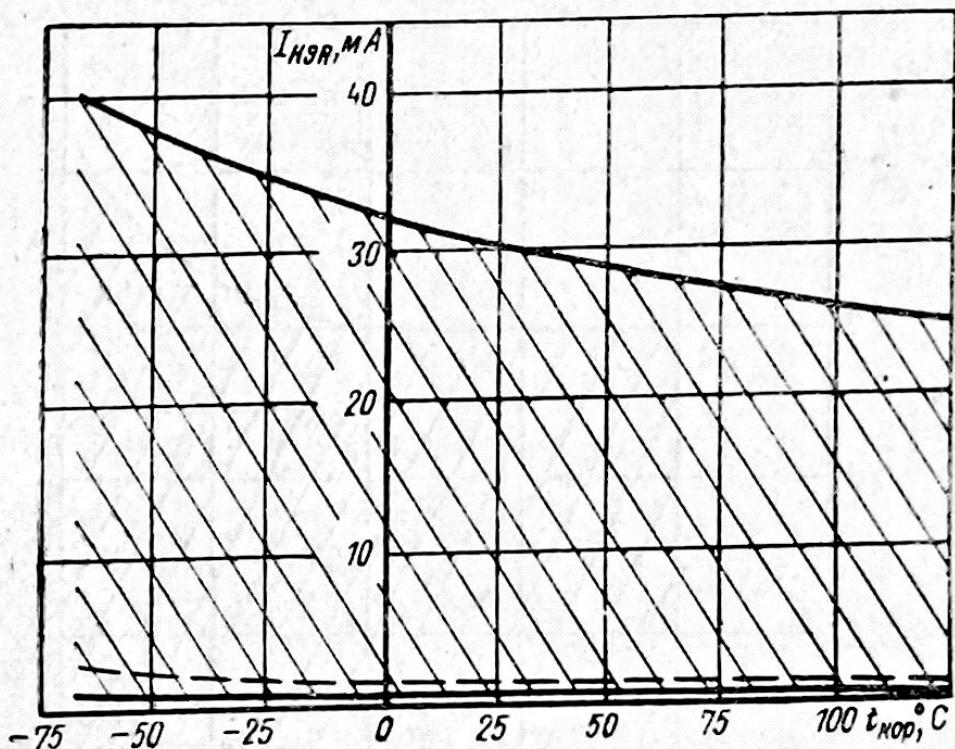


**2T947A**

**КРЕМНИЕВЫЙ ТРАНЗИСТОР**  
*n-p-n*

**ОБЛАСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ ОБРАТНОГО ТОКА  
КОЛЛЕКТОР—ЭМИТЕР В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ КОРПУСА**  
(границы 95% разброса)

При  $U_{\text{КЭ}} = 100$  В и  $R_{\text{БЭ}} = 10$  Ом

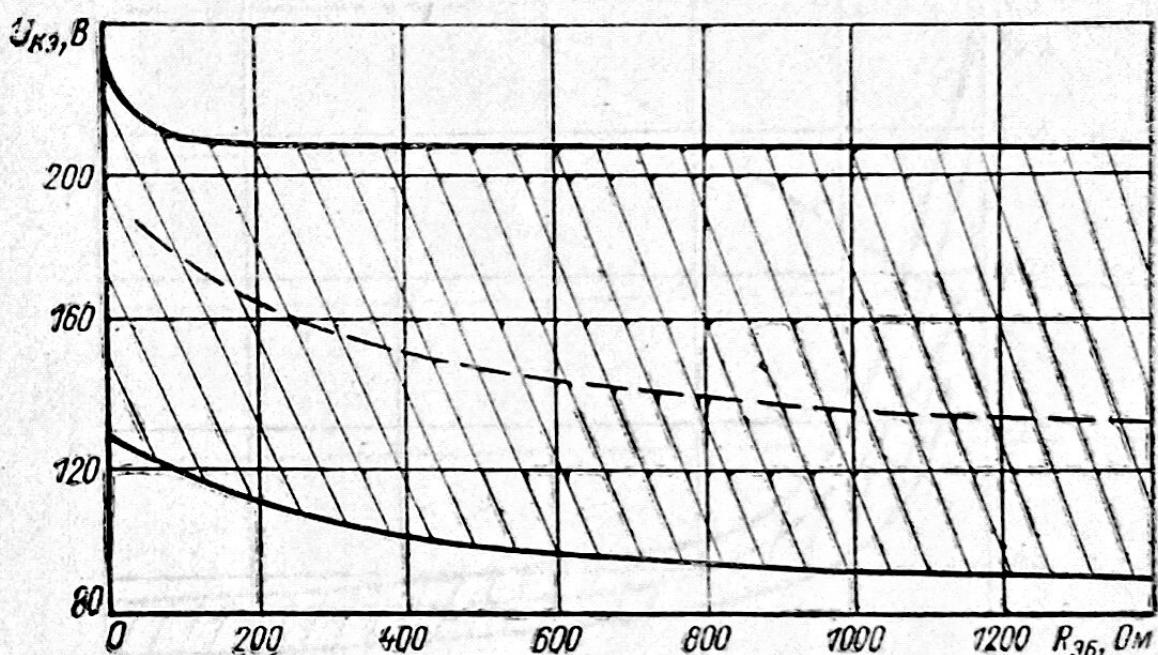


**КРЕМНИЕВЫЙ ТРАНЗИСТОР**  
*n-p-n*

**2T947A**

ОБЛАСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ КОЛЛЕКТОР—ЭМИТЕР  
 В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СОПРОТИВЛЕНИЯ В ЦЕПИ БАЗА—ЭМИТЕР  
 (границы 95 % разброса)

При  $t_{\text{кор}} = 25 \pm 10^{\circ}\text{C}$



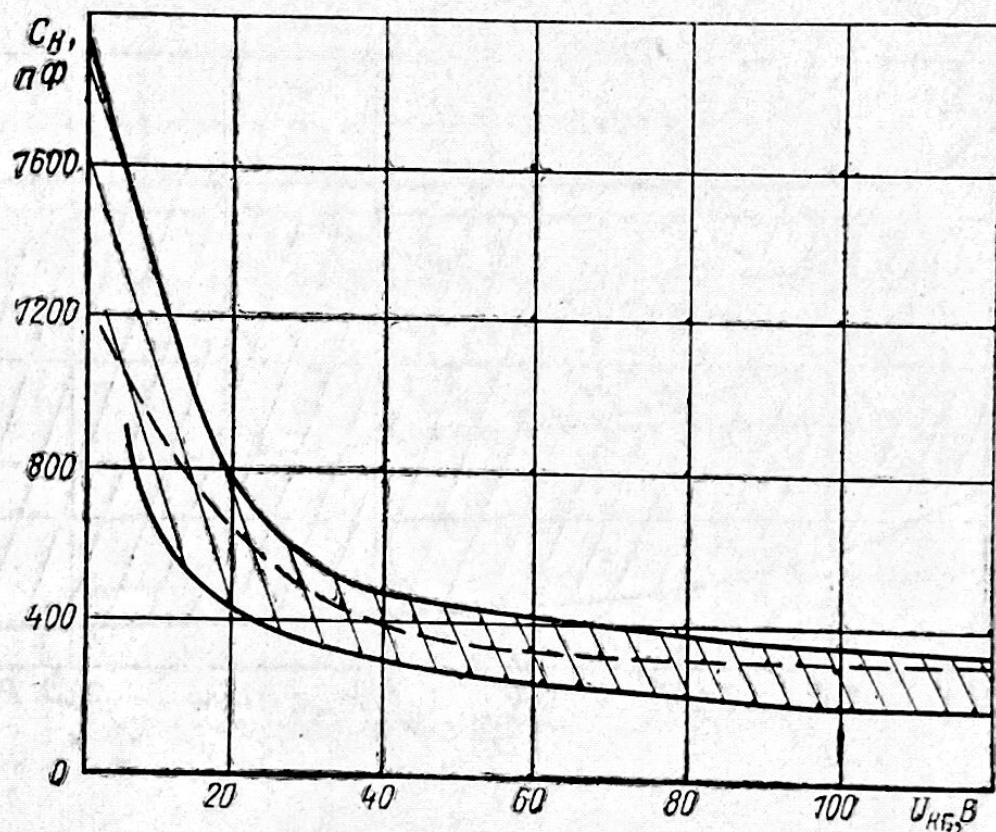
**2T947A**

**КРЕМНИЕВЫЙ ТРАНЗИСТОР**

*n-p-n*

ОБЛАСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ ЕМКОСТИ КОЛЛЕКТОРНОГО ПЕРЕХОДА  
НА ЧАСТОТЕ 1 МГц В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАПРЯЖЕНИЯ КОЛЛЕКТОРА  
(границы 95% разброса)

При  $t_{\text{кор}} = 25 \pm 10^{\circ}\text{C}$



КРЕМНИЕВЫЙ ТРАНЗИСТОР  
*n-p-n*

**2T947A**

ХАРАКТЕРИСТИКА НАИБОЛЬШЕЙ ПОСТОЯННОЙ  
РАССЕИВАЕМОЙ МОЩНОСТИ КОЛЛЕКТОРА  
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ КОРПУСА

При  $U_K \leqslant 10$  В

